

财 政 部
国家税务总局 文件
发 展 改 革 委
工 业 和 信 息 化 部

财税〔2015〕6 号

财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和
信息化部关于进一步鼓励集成电路产业
发展企业所得税政策的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局、地方税务局、发展改革委、工业和信息化主管部门：

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《国家集成电路产业发展推进纲

要》精神，为进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，现将进一步鼓励集成电路产业发展的企业所得税政策通知如下：

一、符合条件的集成电路封装、测试企业以及集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业，在2017年（含2017年）前实现获利的，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止；2017年前未实现获利的，自2017年起计算优惠期，享受至期满为止。

二、本通知所称符合条件的集成电路封装、测试企业，必须同时满足以下条件：

1. 2014年1月1日后依法在中国境内成立的法人企业；
2. 签订劳动合同关系且具有大学专科以上学历的职工人数占企业当年月平均职工总人数的比例不低于40%，其中，研发人员占企业当年月平均职工总数的比例不低于20%；
3. 拥有核心关键技术，并以此为基础开展经营活动，且当年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入（主营业务收入与其他业务收入之和，下同）总额的比例不低于3.5%，其中，企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%；
4. 集成电路封装、测试销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于60%；

5. 具有保证产品生产的手段和能力, 并获得有关资质认证(包括ISO质量体系认证、人力资源能力认证等);

6. 具有与集成电路封装、测试相适应的经营场所、软硬件设施等基本条件。

三、本通知所称符合条件的集成电路关键专用材料生产企业或集成电路专用设备生产企业, 必须同时满足以下条件:

1. 2014年1月1日后依法在中国境内成立的法人企业;

2. 签订劳动合同关系且具有大学专科以上学历的职工人数占企业当年月平均职工总人数的比例不低于40%, 其中, 研究开发人员占企业当年月平均职工总数的比例不低于20%;

3. 拥有核心关键技术, 并以此为基础开展经营活动, 且当年度的研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不低于5%, 其中, 企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%;

4. 集成电路关键专用材料或专用设备销售收入占企业销售(营业)收入总额的比例不低于30%;

5. 具有保证集成电路关键专用材料或专用设备产品生产的手段和能力, 并获得有关资质认证(包括ISO质量体系认证、人力资源能力认证等);

6. 具有与集成电路关键专用材料或专用设备生产相适应的经营场所、软硬件设施等基本条件。

集成电路关键专用材料或专用设备的范围, 分别按照《集成

《集成电路关键专用材料企业所得税优惠目录》（附件1）、《集成电路专用设备企业所得税优惠目录》（附件2）的规定执行。

四、符合本通知规定条件的企业，应在年度终了之日起4个月内，按照本通知及企业所得税相关税收优惠政策管理的规定，凭省级相关部门出具的证明向主管税务机关办理减免税手续。

省级相关部门证明出具办法，由各省（自治区、直辖市、计划单列市）发展改革委、工业和信息化主管部门会同财政、税务等部门研究确定。

五、享受上述税收优惠的企业有下述情况之一的，应取消其享受税收优惠的资格，并补缴存在以下行为所属年度已减免的企业所得税税款：

1. 在申请认定过程中提供虚假信息的；
2. 有偷、骗税等行为的；
3. 发生重大安全、质量事故的；
4. 有环境等违法、违规行为，受到有关部门处罚的。

六、享受税收优惠的企业，其税收优惠条件发生变化的，应当自发生变化之日起15日内向主管税务机关报告；不再符合税收优惠条件的，应当依法履行纳税义务；未依法纳税的，主管税务机关应当予以追缴。同时，主管税务机关在执行税收优惠政策过程中，发现企业不符合享受税收优惠条件的，可暂停企业享受的相关税收优惠，并提请相关部门进行有关条件复核。

七、集成电路封装、测试企业以及集成电路关键专用材料生

产企业、集成电路专用设备生产企业等依照本通知规定可以享受的企业所得税优惠政策与其他定期减免税优惠政策存在交叉的，由企业选择一项最优惠政策执行，不叠加享受。

八、本通知自2014年1月1日起执行。

附件：1. 集成电路关键专用材料企业所得税优惠目录

2. 集成电路专用设备企业所得税优惠目录

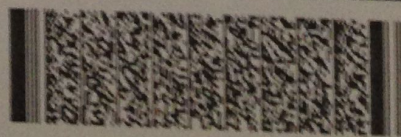


信息公开选项：主动公开

抄送：财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处。

财政部办公厅

2015年3月2日印发



附件1

集成电路关键专用材料企业所得税优惠目录

序号	产品名称	应用领域	主要技术指标
一、功能材料			
1	硅单晶	制作集成电路的关键基础原料,可用直拉、悬浮区熔和中子嬗变掺杂制备。	1、直径: $150 \pm 0.2 \sim 300 \pm 0.2$ 毫米 2、表面洁净区厚度 > 10 微米 3、表面无 COP 缺陷 (≥ 0.1 微米)
2	硅外延片	主要用于制作 CMOS 电路、各类晶体管以及绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 等。	1、厚度、电阻率均匀性的控制: 要求厚度均匀性 $< 2\%$, 电阻率均匀性 $< 4\%$ 2、降低外延层的结构缺陷: 要求颗粒控制到: 60ea (> 0.065 微米), 40ea (> 0.10 微米), 20ea (> 0.20 微米) 3、表面金属含量 $\leq 1.0 \times 10^{10}$ atoms/平方厘米 4、背面金属含量 $\leq 5.0 \times 10^{10}$ atoms/平方厘米 5、达到 100% 的外延无滑移线 6、平整度的控制达 TIR < 1.7 微米, SFQR < 0.15 微米, 25 毫米 $\times$ 25 毫米
3	硅抛光片	主要用于制作集成电路等半导体器件或用作硅外延沉积的衬底	1、厚度: 200 ~ 775 微米 2、总厚度变化: ≤ 10 微米 3、弯曲度: < 35 微米 4、翘曲度: < 45 微米

序号	产品名称	应用领域	主要技术指标
二、结构材料			
1	键合丝	用于半导体器件封装的电极部位或芯片与外部引线连接的金属材料	1、直径: ≤ 75 微米 2、纯度: $> 4N(99.99\%)$ 3、长度: > 300 米
			1、直径: ≤ 30 微米 2、纯度: $> 4N(99.99\%)$ 3、长度: > 300 米
2	引线框架	用于为芯片提供机械支撑载体,并作为导电介质连接IC外部电路,传输信号,以及与封装材料一起,向外散热。	1、厚度: $0.1 \sim 2.0$ 毫米 2、宽度: $18 \sim 610$ 毫米 3、侧边弯曲度: 宽度 ≤ 100 毫米,侧边弯曲度 ≤ 1.0 毫米/米; 宽度 >100 毫米,侧边弯曲度 ≤ 1.5 毫米/米
3	塑封料	用来代替金属、陶瓷或玻璃对电子元器件进行封装的塑料材料。	1、弯曲强度: > 130 兆帕 2、弯曲模量: > 12000 兆帕 3、线膨胀系数: $1.0 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C} \sim 8.0 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$
三、微细加工材料			
1	光刻胶	主要用于将光刻掩膜版上的图形转移到晶圆片上。	1、痕量金属离子: $> 6N(99.9999\%)$ 2、水分: $\leq 0.5\%$
2	靶材	在薄膜淀积工艺中用于沉积到目标结构上的材料,主要包括金属、陶瓷和合金材料。	1、纯度: $> 5N(99.999\%)$

序号	产品名称	应用领域	主要技术指标
四、工艺辅助材料			
1	高纯化学试剂	双氧水	纯度：>6N8 (99.99998%)
		氨水	纯度：>6N8 (99.99998%)
		异丙醇	纯度：>6N8 (99.99998%)
		磷酸	纯度：>6N8 (99.99998%)
		氢氟酸	纯度：>6N8 (99.99998%)
		盐酸	纯度：>6N8 (99.99998%)
		硫酸	纯度：>6N8 (99.99998%)
		BOE (氟化铵+氢氟酸混合酸)	纯度：>6N8 (99.99998%)
		硝酸	纯度：>6N8 (99.99998%)
		四甲基氢氧化铵	纯度：>6N8 (99.99998%)
		主要用于硅晶圆表面清洗、芯片的清洗和腐蚀等。	

附件2

集成电路专用设备企业所得税优惠目录

序号	产品名称	应用领域	主要技术指标
一、集成电路硅单晶片生长加工设备			
1	硅芯炉	用于多晶硅生长载体——硅芯的制备。	1、原料规格：直径 75~80 毫米，长度 450 毫米 2、成品规格：直径 7~8.5 毫米，长度 2500~2800 毫米 3、生产能力： ≥ 5 根/次， ≥ 15 根/炉次
2	带锯截断机床	用于硅单晶棒切断、切头尾。	1、最大装夹：直径 ≥ 8 英寸，长度 ≥ 1500 毫米 2、加工精度：8 英寸，凹凸误差 $\leq \pm 0.2$ 毫米
3	X 射线晶体定向仪	利用 X 射线衍射原理，精密快速地测定半导体晶体的切割角度，与切割机配套用于上述晶体的定向切割。	1、X 射线管：铜靶，阳极接地，强制风冷 2、管电压：30 千伏；管电流：0~50 毫安，连续可调 3、整机功耗：不大于 0.3 瓦 4、计数管电压：500 伏~1100 伏 5、时间常数：0.1、0.4、3 秒三档
4	全自动软轴单晶炉	生产大规模集成电路所需要的高质量单晶。	1、生长晶体的直径范围：8~12 英寸 2、熔料重量： ≥ 100 千克 3、原料：多晶硅原料 4、硅单晶等径长度： ≥ 1000 毫米(8 英寸) 5、主炉室尺寸：直径 900 毫米，长度 1250 毫米
5	多线切割机	用于 90~65 纳米集成电路用 300 毫米硅片及以下直径半导体硅片的加工。	1、自动最大切割尺寸：直径 310 毫米，长度 400 毫米 2、使用线径：0.1~0.18 毫米 3、工作台切割速度：0.01~9 毫米/分钟

序号	产品名称	应用领域	主要技术指标
6	精密双面抛光机	用于 12 英寸及 12 英寸以下集成电路硅片的双面抛光。	1、抛光盘尺寸: 430~1420 毫米 2、游轮参数: 齿数 $Z=105$, 齿距 $P=15.7$ 3、游轮数量: 5 片 4、硅片加工后 GBIR (抛光前 $GBIR < 2$ 微米, 去除量约为 10~40 微米) ≤ 0.6 微米 5、硅片加工后 SFQR (cell size 25×25) PUA95% (大) ≤ 0.07 微米 (EE=2 毫米)
二、集成电路晶圆芯片生产设备			
1	0.1 微米 1CFM 大流量激光尘埃粒子计数器	用于测量集成电路晶圆生产超净室单位体积空气中的微细尘埃粒子的粒净及数量。	1、粒径通道: 0.1、0.3、0.5、1、5、10 2、采样流量: ≥ 50 升/分钟 3、传感器信噪比: $> 3: 1$
2	介质等离子刻蚀机	用于集成电路芯片极深接触孔刻蚀、硬模板刻蚀、金属接触孔刻蚀、浅槽刻蚀等介电质刻蚀工艺。	1、晶圆尺寸: 8~12 英寸 2、线宽: ≤ 90 纳米 3、深宽比刻蚀能力: $\geq 30: 1$ 4、刻蚀速度: > 8000 埃米/分钟 5、刻蚀均匀性误差: $< 3\%$ 6、线宽精度: < 3 纳米 7、模板刻蚀选择性: $> 10: 1$ 8、微粒杂质: < 10 个
3	高密度等离子刻蚀机	适用于多晶硅栅极刻蚀、浅沟槽隔离刻蚀、原位硬掩膜刻蚀和光刻胶调整等多种工艺应用。	1、晶圆尺寸: 8~12 英寸 2、线宽: ≤ 100 纳米 3、深宽比: $\geq 50: 1$
4	匀胶显影机	用于硅晶圆片涂复光刻胶和显影。	1、晶圆尺寸: 6~12 英寸

序号	产品名称	应用领域	主要技术指标
5	晶圆片清洗设备	用于集成电路硅晶圆片抛光、扩散前、CMP后、氧化前及光刻后等工艺的清洗。	1、晶圆尺寸：8~12 英寸 2、线宽：≤90 纳米 3、颗粒清除效率（PRE）：99% 4、兆声波能量费均匀度：2%
6	集成电路光掩模清洗设备	用于集成电路光掩模的正反面自动进行清洗。	1、自动进行酸洗、碱洗、兆声洗、去离子热水及冷水清洗 2、线宽：≤130 纳米 3、产量：≥3 片/小时
7	快速退火炉	用于对集成电路硅晶圆片进行热处理。	1、晶圆尺寸：8~12 英寸 2、温控范围：400~1200℃ 3、控温精度：≤±2℃
8	大角度离子注入机	用于集成电路源漏区的晕（Halo）、袋（Pocket）、栅阈值调整（Vt）等进行离子注入工艺。	1、晶圆尺寸：8~12 英寸 2、离子源寿命：>300 小时 3、离子源能量：5~810 千电子伏 4、离子种类：B ⁺ 、P ⁺ 、As ⁺ 、Ar ⁺ 5、传送速度：≥230 片/小时
9	立式氧化炉	用于集成电路干氧氧化、湿氧氧化、DCE 氧化、氮氧化硅氧化和退火工艺。	1、硅晶圆片直径：8~12 英寸 2、最大处理枚数：125 枚（12 英寸） 3、恒温区：1044 毫米
10	铜互连清洗设备	用于集成电路通孔刻蚀后、沟槽刻蚀后、衬垫刻蚀后的清洗和背面清洗、边缘清洗以及铜互连化学机械抛光清洗。	1、硅晶圆片直径：12 英寸 2、线宽：≤65 纳米 3、腔室数量：8~10 个 4、产能：≥160 片/小时

序号	产品名称	应用领域	主要技术指标
11	扩散炉	用于集成电路硅晶片进行扩散、氧化、退火、合金及烧结等工艺。	1、晶圆尺寸：8~12 英寸 2、工作温度：400~1300℃ 3、恒温区温度精度： $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (600~1250℃)
12	低压化学汽相淀积系统	用于在集成电路晶圆片上生长多晶硅及氮化硅薄膜。	1、晶圆尺寸：8~12 英寸 2、工作温度：400~1100℃ 3、恒温区温度精度： $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$
13	等离子增强化学汽相淀积系统	用于在集成电路晶圆片上生长钝化与多层布线介及氮化硅薄膜。	1、晶圆尺寸：8~12 英寸 2、工作温度：100~500℃ 3、恒温区温度精度： $\leq \pm 3^{\circ}\text{C}$

三、集成电路封装测试设备

1	高速自动冲切成型系统	用于 QFP、LQFP、TSOP 类塑封后产品的冲浇口、冲塑切筋、连筋检测、预分离、打弯成型、引线切断、整型、分离装盘。	1、冲切速度： ≥ 120 次/分钟；分离速度： ≥ 60 次/分钟 2、一次最多可分离双列 8 排 16 颗产品 3、MTBA： ≥ 30 分钟 4、成型后，引脚平坦度 0.04 毫米以内 5、产品冲裁毛刺： ≤ 0.05 毫米 6、引线压痕： ≤ 0.015 毫米（框架电镀厚度单边 0.01 毫米的情况下） 7、切筋凸台：0~0.06 毫米，无凹口
2	集成电路自动封装系统	用于中高档集成电路产品的后工序自动化封装。系统集上片、上料、预热、装料、清模、去胶和收料于一体。	1、合模压力范围： ≤ 170 吨 2、注射压力范围： ≤ 4 吨 3、系统机械时间： ≤ 22 秒 4、封装制品上下型偏错位： ≤ 0.038 毫米 5、塑封体与引线框架偏错位： ≤ 0.038 毫米

序号	产品名称	应用领域	主要技术指标
3	塑封压机	自动通过塑封压机种的塑封型模完成对集成电路芯片上芯、金丝键合工序后的半成品进行塑料封装，以便芯片得到保护。	快速合模：≤127 毫米/秒钟 慢速合模：≤18 毫米/秒钟 快速回复合模：≤120 毫米/秒钟 慢速回复合模：≤32 毫米/秒钟 快速注射：≤158 毫米/秒钟 慢速注射：≤28 毫米/秒钟
4	高频预热机	用于集成电路的塑料封装，可有效的对环氧树脂、酚醛树脂等饼状塑封料及密胺（美耐皿）等粉状材料进行快速加热，以达到清除水份，减少有害成份，增强粉料流动性，塑封料延流性，提高产品品质。	1、料饼直径：0~55 毫米，可调整 2、预热时间：0~99 秒钟，可调整 3、预热电压：6400 伏~7500 伏，分三档，可调整 4、中心主振频率：72 兆赫兹（±5%） 5、极限阳极电流：0.8 安（直流）
5	紧凑型全自动 IC 料条激光打标机	用激光在 IC 料条上连续不间断打标记。	1、弹夹：堆栈式 2、产能：≥1000 片/小时（打印没有空跑） 3、转换时间：<15 分钟 4、料条长度：150~260 毫米 5、料条宽度：20~70 毫米；料条厚度：0.15~2 毫米
6	环氧粘片机	用于将芯片粘接到引线框架上。	1、自动手动 Z 行程：14 毫米 2、手控 X-Y 范围：15 毫米×15 毫米 3、升降台 Z 行程：18 毫米 4、θ 轴 360° 旋转，芯片精确定位 5、粘片压力：10 克~100 克 6、粘片尺寸：0.2~25 毫米

序号	产品名称	应用领域	主要技术指标
7	模数混合集成电路测试系统	用于模拟集成电路、音频和数模混合集成电路的测试。	1、八路小功率电压电流源 LVI (± 20 伏 / ± 200 毫安) 2、双路大功率电压电流源 DPVI (± 50 伏 / ± 10 安) 3、双路中功率电压电流源 MVI (± 50 伏 / ± 400 毫安)
8	多功能全自动激光打标机	自动将条式 IC 料条传送到流道上, 首先用 CCD 相机对料条进行方向判断并读取 ID 二维码, 接着把方向正确的料条传送到激光打标范围并对其精确定位 (采用定位针定位及 CCD 相机坐标定位), 使用双头光纤激光一次性完成整条 IC 的精确标刻。最后将已标刻的合格料条自动装回料盒。	1、适合料条宽度: 20 ~ 120 毫米 2、适合料条长度: 160 ~ 250 毫米 3、激光标刻精度: ± 50 微米 4、线宽: 0.03 ~ 0.12 毫米可调 (用光圈的大小实现可调) 5、线深: 0.01 ~ 0.06 毫米可调 6、打印合格率: $\geq 99.99\%$ 7、生产效率: ≥ 1200 条/小时 (激光不工作) 8、更换产品时间: < 30 分钟 9、设备具备 MAPING 功能 QFN mapping 10、方向检测功能: 识别料条的前后正反和左右正反 (印前 Vision 检测、打印区防反针检测)
9	全自动上片机 (粘片机)	用于将机场电路芯片从晶圆蓝膜上取出放到框架或基板上。	1、芯片尺寸: 0.6 毫米 $\times$ 0.6 毫米 ~ 12.5 毫米 $\times$ 12.5 毫米 2、上片速度: 5000 (2 毫米 $\times$ 2 毫米) 以上

序号	产品名称	应用领域	主要技术指标
10	托盘式全自动编带机	采用自动上下料和料盘传送装置, 将托盘内的 IC 芯片使用 2D、3D 检测系统对其表面缺陷、标刻内容及三维外观进行扫描检查并储存记忆, 通过分选机构把次品料集中抓放到次品收集盘内, 将合格料抓放到载带内, 最终完成编带封装收卷功能。	1、进料方式: JEDEC 料盘式 2、UPH: ≥ 10000 个/小时 (QFN3 $\times$ 3), ≥ 8000 个/小时 (QFN4 $\times$ 4 以上) 3、2D 检测误判率: $< 0.2\%$ 4、3D 检测误判率: $< 0.3\%$ 5、对载带和盖带具备三档兼容能力: 8~16 毫米; 16~24 毫米; 24~36 毫米
11	光学检测机	设备采用高倍显微镜进行 PC 或人工观测, 再进行二维码读取, 将料条的 Mapping 采用符合 SEMI 标准的格式上传送到服务器上, 为半导体后道打标做准备。	1、UPH: 600strips (没有目检和二维码) 2、损伤料条率: 0 3、可兼容料条规格: 长度 160~250 毫米; 宽度 40~70 毫米 4、料条最大弯曲度: 3 毫米 5、芯片外形尺寸: 0.2 毫米 $\times$ 0.2 毫米~40 毫米 $\times$ 40 毫米 6、可兼容槽式弹夹尺寸: 长度 160~260 毫米; 宽度 45~80 毫米; 高度 100~170 毫米 7、料条最小间距: ≤ 1.2 毫米
12	半自动晶圆背面标刻机	用于 IC 晶圆背面激光标刻。	1、产能: ≥ 20 片/小时 2、上下料时间: < 1 分钟 3、晶圆尺寸: 4 寸、6 寸、8 寸 4、标刻精度: ± 20 微米

序号	产品名称	应用领域	主要技术指标
13	全自动划片机	用于 8 英寸及以下集成电路晶圆划切分割。	1、自动可加工晶圆尺寸： ≥ 8 英寸 2、主轴：转速 6000 ~ 60000 转/分钟 3、功率：1.8 千瓦 4、X 轴：划切范围 210 毫米，进刀速度 0.1 ~ 500 毫米/秒钟；Y 轴：划切范围 210 毫米，定位精度 0.003 毫米/210 毫米；Z 轴：最大刀片直径 58 毫米，重复精度 0.002 毫米 5、 θ 轴：转角 380°
14	先进封装用步进投影光刻机	用于集成电路后道凸块 (Bump) 工艺，如：金凸块、铅锡凸块、铜柱晶圆级封装和重新布线等。	1、晶圆尺寸：8 ~ 12 英寸 2、曝光视场：44 毫米 $\times$ 44 毫米 3、焦深：30 微米 (在曝光 3 微米密集线条时) 4、单机套刻精度： < 0.6 微米
15	自动探针测试台	用于集成电路芯片的测试，与测试仪连接后，能自动完成对芯片的电参数测试及功能测试。	1、可测片径： ≥ 6 英寸 2、工作台最大行程：180 毫米 $\times$ 240 毫米 3、工作台速度： ≥ 200 毫米/秒钟 4、定位精度： $\leq \pm 0.01$ 毫米/160 毫米 5、承片台 Z 向行程：10 毫米 6、 θ 向调节范围： $\pm 10^\circ$
16	全自动晶圆检测机	采用高分辨率彩色摄像头进行图像采集和存储对 IC 晶圆表面缺陷检测。	1、晶圆检测范围尺寸：4 ~ 8 英寸 2、最小检测的缺陷： ≥ 1 微米 3、一次图像处理范围：10 毫米 $\times$ 10 毫米 4、UPH： > 70 片晶圆/小时
17	集成电路全自动测试分选机	用于封装后的集成电路自动测试和分选。	1、测试工位：1 ~ 4 个 2、自动上、下料